

Памяти Людмилы Германовны Лаврентьевой



30 мая 2008 г. после тяжелой болезни ушла из жизни Людмила Германовна Лаврентьева — замечательный ученый, доктор физико-математических наук, профессор.

Л.Г. Лаврентьева в 1953 г. окончила физический факультет Томского государственного университета, в 1960 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в 1982 г. докторскую. С 1961 г. Л.Г. Лаврентьева работала в Сибирском физико-техническом институте (СФТИ) им. академика В.Д. Кузнецова, где в 1973 г. ею была создана лаборатория эпитаксиальных структур. Основное научное направление — эпитаксия арсенида галлия, материала, заниматься которым в СФТИ начали по рекомендации А.Ф. Иоффе и Д.Н. Наследова. Впервые в СССР Л.Г. Лаврентьевой были получены эпитаксиальные слои арсенида галлия (1961 г.), предложено использовать вицинальные поверхности подложек для производства высококачественных слоев (1964 г.), проведен комплекс исследований кинетики и механизмов роста эпитаксиальных пленок в условиях газофазной эпитаксии, выполнено моделирование процессов роста, изучены физические особенности эпитаксиальных слоев. Л.Г. Лаврентьева внесла существенный вклад в материаловедение полупроводников и, в частности, в научное направление „Физические основы газофазной эпитаксии полупроводников группы $A^{III}B^V$ “. Научные труды Л.Г. Лаврентьевой в области эпитаксии полупроводников широко известны в России и за рубежом.

Она является автором и соавтором более 230 научных статей, в том числе заказных и обзорных.

Наряду с научной деятельностью много внимания Людмила Германовна уделяла педагогической работе в Томском государственном университете. С 1982 г. под её руководством была организована подготовка специалистов по физике полупроводников, а в 1991 г. была создана кафедра физики полупроводников на физическом факультете университета, которую она возглавляла до 2002 г. В 1998 г. при её непосредственном участии был создан филиал кафедры в Институте физики полупроводников СО РАН (г. Новосибирск). Л.Г. Лаврентьева являлась научным руководителем и консультантом аспирантов, соискателей и докторантов. Под её руководством защищены 12 кандидатских диссертаций, а два ее аспиранта стали докторами наук.

В течение многих лет Л.Г. Лаврентьева являлась членом редколлегии журналов „Известия вузов. Физика“, „Известия вузов. Материалы электронной техники“, членом Научных советов РАН „Рост кристаллов“ и „Физико-химические основы материаловедения полупроводников“, членом Азиатско-Тихоокеанской академии материалов, действительным членом РАЕН, почетным работником высшего профессионального образования России, награждена почетным знаком Минвуза СССР „За отличные успехи в работе“. Она активно работала в советах по защите докторских и кандидатских диссертаций в Томском государственном университете.

Энергия, преданность науке, способность подбирать сотрудников при формировании коллектива, широкий научный кругозор, доброжелательность и готовность оказать профессиональную помощь создавали Л.Г. Лаврентьевой высокий авторитет и уважение среди коллег.

Талантливый ученый и организатор Людмила Германовна Лаврентьева останется в памяти всех, кто ее знал.

*А.Л. Асеев, Ф.А. Кузнецов, И.Г. Неизвестный,
О.П. Пчеляков, Г.В. Майер, В.М. Кузнецов,
М.Г. Мильвидский, Б.Г. Захаров, Г.Е. Дунаевский,
А.И. Потекаев, А.П. Вяткин, О.П. Толбанов,
В.Н. Брудный, И.В. Ивонин, М.Д. Вилисова,
В.Г. Гермогенов, М.Я. Дашевский, С.С. Хлудков*

*Редколлегия журнала
«Физика и техника полупроводников»*